



ND³⁺离子敏化的抗辐射激光晶体ND,ER:GSGG及其制备方法

文献类型: 专利

.....

作者 张庆礼¹; 罗建乔¹; 孙敦陆¹; 谷长江¹

发表日期 2009

专利国别 中国

专利号 101409424

专利类型 发明

权利人 中国科学院安徽光学精密机械研究所

公开日期 2013-01-10

申请日期 2007

专利申请号 200710134395.4

源URL [http://ir.hfcas.ac.cn/handle/334002/9678]

专题 合肥物质科学研究院_中科院安徽光学精密机械研究所

推荐引用方式 张庆礼,罗建乔,孙敦陆,等. ND³⁺离子敏化的抗辐射激光晶体ND,ER:GSGG及其制备方法, ND³⁺离子敏化的抗辐射激光晶体ND,ER:GSGG及其制备方法, ND³⁺离子敏化的抗辐射激光晶体ND,ER:GSGG及其制备方法, ND³⁺离子敏化的抗辐射激光晶体ND,ER:GSGG及其制备方法, ND³⁺离子敏化的抗辐射激光晶体ND,ER:GSGG及其制备方法, ND³⁺离子敏化的抗辐射激光晶体ND,ER:GSGG及其制备方法, ND³⁺离子敏化的抗辐射激光晶体ND,ER:GSGG及其制备方法, ND³⁺离子敏化的抗辐射激光晶体ND,ER:GSGG及其制备方法, ND³⁺离子敏化的抗辐射激光晶体ND,ER:GSGG及其制备方法, ND³⁺离子敏化的抗辐射激光晶体ND,ER:GSGG及其制备方法. 101409424. 2009-01-01.

入库方式: OAI收割

来源: [合肥物质科学研究院](#)

浏览	下载	收藏
276	94	0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。

